产品分类目录

无源射频网络与阻抗器件

面向射频负载、终端、匹配与均衡网络、偏置隔离及相关阻抗控制器件的工程选型，重点限定频率、参考阻抗、反射、功率、温度和环境边界。

产品: 11

版本: 6 · 修订日期: 2026-11-11



射频电阻器



LCRES-R15OHM

15 Ω GaAs薄膜电阻裸芯片

电阻值: 15 Ω (典型值); 线性工作电流: 0.35 A (典型值); 最大承受电流: 0.8 A (最大值). 裸片平面尺寸: 0.5 × 0.5 mm.

电阻数量: 数值: 1

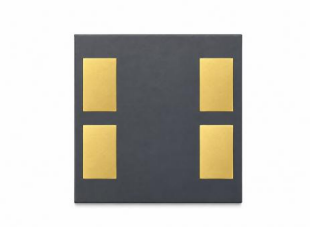
端口数量: 数值: 2

电阻值: 典型值: 15; 单位: Ω

阻值精度: 典型值: ±5; 单位: %

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCRES-N2-R20OHM

2 × 20 Ω GaAs薄膜电阻裸芯片

电阻值: 20 / 20 Ω (典型值); 线性工作电流: 0.165 / 0.165 A (典型值); 最大承受电流: 0.33 A (最大值). 裸片平面尺寸: 0.5 × 0.5 mm.

电阻数量: 数值: 2

端口数量: 数值: 4

电阻值: 典型值: 20 / 20; 单位: Ω

阻值精度: 典型值: ±5; 单位: %

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCRES-R50OHM

50 Ω GaAs薄膜电阻裸芯片

电阻值: 50 Ω (典型值); 线性工作电流: 0.2 A (典型值); 最大承受电流: 0.6 A (最大值). 裸片平面尺寸: 0.5 × 0.5 mm.

电阻数量: 数值: 1

端口数量: 数值: 2

电阻值: 典型值: 50; 单位: Ω

阻值精度: 典型值: ±5; 单位: %

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCRES-R1000OHM

1000 Ω GaAs薄膜电阻裸芯片

电阻值: 1000 Ω (典型值); 线性工作电流: 0.04 A (典型值); 最大承受电流: 0.08 A (最大值). 裸片平面尺寸: 0.5 × 0.5 mm.

电阻数量: 数值: 1

端口数量: 数值: 2

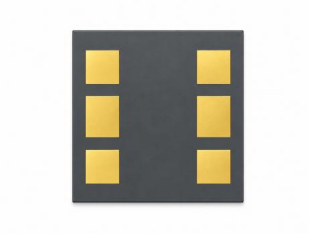
电阻值: 典型值: 1000; 单位: Ω

阻值精度: 典型值: ±5; 单位: %

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书

射频电容器



LCCAP-C10PF

10 pF GaAs电容裸芯片

电容值: 10 pF (典型值); 耐压: 50 V (典型值). 裸片尺寸: 0.5 × 0.5 × 0.1 mm.

电容值: 典型值: 10; 单位: pF; TA = +25 °C

耐压: 典型值: 50; 单位: V; TA = +25 °C

击穿电压: 数值: 80 (Vb); 单位: V

储存温度: 最小值: -65; 最大值: 150; 单位: °C

产品详情　产品规格书

射频均衡器



LCEQ-8000-12000-D

8000–12000 MHz GaAs斜率均衡器裸芯片

均衡量: 2 dB; 插入损耗 @ 8000 MHz: 2.6 dB; 插入损耗 @ 12000 MHz: 0.7 dB. 裸片尺寸: 0.8 × 0.8 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

均衡量: 数值: 2; 单位: dB

插入损耗 @ 8000 MHz: 数值: 2.6; 单位: dB

插入损耗 @ 12000 MHz: 数值: 0.7; 单位: dB

产品详情　产品规格书



LCEQ-2000-6000-D

2000–6000 MHz GaAs斜率均衡器裸芯片

均衡量: 5.5 dB; 插入损耗 @ 2000 MHz: 0.6 dB; 插入损耗 @ 6000 MHz: 6.1 dB. 裸片尺寸: 0.8 × 0.9 × 0.1 mm.

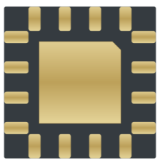
工作频率: 最小值: 2000; 最大值: 6000; 数值: 2000–6000; 单位: MHz

均衡量: 数值: 5.5; 单位: dB

插入损耗 @ 2000 MHz: 数值: 0.6; 单位: dB

插入损耗 @ 6000 MHz: 数值: 6.1; 单位: dB

产品详情　产品规格书



LCEQ-8000-12000-C

8000–12000 MHz 封装射频均衡器 — ΔIL 2 dB; IL -3.1 → -1.1 dB (典型值)

8000–12000 MHz; 均衡量 2 dB (典型值); 频段下限插入损耗 -3.1 dB (典型值) @ 8000 MHz; 频段上限插入损耗 -1.1 dB (典型值) @ 12000 MHz.

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

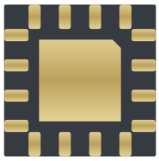
频段下限插入损耗: 典型值: -3.1; 数值: f = 8000 MHz; 单位: dB

频段上限插入损耗: 典型值: -1.1; 数值: f = 12000 MHz; 单位: dB

均衡量: 典型值: 2; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCEQ-2000-6000-C

2000–6000 MHz 封装射频均衡器 — ΔIL 5.5 dB; IL -1 → -6.5 dB (典型值)

2000–6000 MHz; 均衡量 5.5 dB (典型值); 频段下限插入损耗 -1 dB (典型值) @ 2000 MHz; 频段上限插入损耗 -6.5 dB (典型值) @ 6000 MHz.

工作频率: 符号: f; 最小值: 2000; 最大值: 6000; 数值: 2000–6000; 单位: MHz

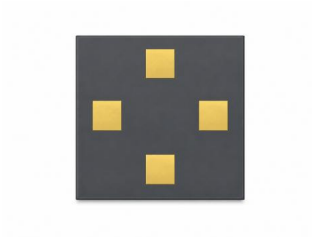
频段下限插入损耗: 典型值: -1; 数值: f = 2000 MHz; 单位: dB

频段上限插入损耗: 典型值: -6.5; 数值: f = 6000 MHz; 单位: dB

均衡量: 典型值: 5.5; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCXOV-DC-40000-D

DC–40000 MHz GaAs射频交叉跳线裸芯片

插入损耗: 0.4 dB (典型值); 隔离度: 30 dB (典型值); 回波损耗: 20 dB (典型值). 裸片尺寸: 0.6 × 0.6 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 40000; 数值: DC–40000; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: 0.4; 单位: dB

隔离度: 典型值: 30; 单位: dB

回波损耗: 典型值: 20; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书

射频负载与假负载



LCLOAD-6000-25

DC–6 GHz 25 W 射频负载

覆盖 DC–6 GHz 的 50 Ω 射频终端负载，连续波功率容量典型值为 25 W、最小值为 20 W，驻波比典型值为 1.3:1。

工作频率: 最小值: DC; 最大值: 6000; 单位: MHz

连续波射频功率容量: 最小值: 20; 典型值: 25; 单位: W

驻波比: 典型值: 1.3:1

阻抗: 典型值: 50; 单位: Ω

25 °C；50 Ω

产品详情　产品规格书

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单

> 文件为准。